

КТ 815 Г

**Кремниевый эпитаксиально-планарный
N-P-N транзистор**

Описание:

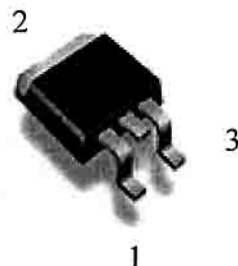
Изготавливается по эпитаксиально-планарной технологии.

Предназначен для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

Поставляется в корпусе КТ-89 (ТО-252АА) ДРАК.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Максимально допустимое значение
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер ($R_{бэ} \leq 100 \text{ Ом}$)	$U_{кэ\text{MAX}}$	В	100
Постоянное напряжение эмиттер-база	$U_{эб\text{MAX}}$	В	5
Постоянный ток коллектора	$I_{к\text{MAX}}$	А	1,5
Постоянный ток базы	$I_{б\text{MAX}}$	А	0,5
Рассеиваемая мощность коллектора	$P_{к\text{MAX}}$	Вт	10
Температура перехода	$T_{п\text{MAX}}$	°С	150



- 1. База
- 2. Коллектор
- 3. Эмиттер

Пониженная рабочая температура среды -60°C

Повышенная рабочая температура среды 125°C

Нормы и режимы электропараметров (Токр.ср.= 25°C)

Параметр	Обозначение	Ед. измер	Режим измерения	Мин	Макс
Обратный ток коллектора	$I_{кб0}$	мкА	$U_{кб}=65 \text{ В}, I_{э}=0$		50
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{кэR}$	мкА	$U_{кэ}=65 \text{ В}, R_{бэ} \leq 100 \text{ Ом}$		100
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		$U_{кб}=2 \text{ В}, I_{э}=0,15 \text{ А}$	30	275
Граничное напряжение	$U_{кэ0 \text{ гр}}$	В	$I_{э}=50 \text{ мА}$	85	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{кэ \text{ нас}}$	В	$I_{к}=500 \text{ мА}, I_{б}=50 \text{ мА}$		0,6